

а 2004 0138

Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности к методам получения полупроводниковых наноструктур.

Сущность изобретения заключается в том, что на одну из поверхностей полупроводникового кристалла путем фотолитографии наносят маску, проводят электрохимическое травление и удаляют маску. Новизна изобретения состоит в том, что после удаления маски дополнительно проводят электрохимическое травление при облучении светом, энергия квантов которого превышает величину запрещенной зоны полупроводника.

П. формулы: 1